

京都大学	博士（工学）	氏名 重松 英		
論文題目	Study on transport and conversion of ac and dc spin current generated by magnetization dynamics (磁化ダイナミクスにより誘起される交流・直流スピントン流の輸送・変換に関する研究)			
(論文内容の要旨)				
<p>本論文は、固体物質中のスピントン流物性を探索する手法として動力学的スピントン注入法に着目し、半導体を中心とした物質中の交流・直流スピントン流の生成ならびに検出実験を行った結果をまとめたものである。</p> <p>第一章は序論であり、スピントロニクスやスピントン流についての背景知識と、本論文の研究に繋がる既存の実験・観測技術の進展について述べている。</p> <p>第二章では、近年スピントン注入源として注目されているイットリウム・鉄・ガーネット(YIG)のスピントン注入効率の温度依存性に関する研究が述べられている。YIGを用いた系での直流スピントンポンピング法では、低い磁化ダンピングによって高いスピントン注入効率を実現でき、かつYIG自身が絶縁体であるために金属磁性体で問題となっていた磁気整流効果の重畠が排除できる。この研究ではこの実験系を半導体等の広範な固体材料に適用することを見据えて、YIGのスピントン注入効率の温度依存性を検証した。温度可変装置を備えた電子スピントン共鳴装置にPt/YIG二層膜構造試料を設置して直流スピントンポンピングによる検出起電力を常温から80Kにわたって測定したところ温度低下に従う一様なスピントン注入効率の低下が見られた。YIGの強磁性共鳴スペクトルの半値幅の温度低下に伴う増大も観測され、磁化ダンピングの低温域における増大がスピントン注入効率の低減の主因であることがわかった。さらに、共鳴周波数を変化させた実験から、磁化ダンピングの温度依存性がYIGの希土類不純物によるSlow Relaxation機構に従うことを見た。</p> <p>第三章では、YIG/半導体界面の形成法として、半導体カーボンナノチューブをYIG基板上に滴下することを試み、スピントン注入実験を行った結果が述べられている。実験ではイオン液体によるゲート構造により半導体カーボンナノチューブにキャリアを誘起させ、直流スピントンポンピング法によるスピントン注入下におけるスピントン流電流変換起電力の観測を試みた。観測された起電力はキャリア変調と磁化方向の双方により反転を示した。一方で、近年YIG表面のスピントン波励起による熱輸送効果が報告されているため、その効果による信号の重畠を検討するために直流スピントンポンピング実験におけるゼーベック起電力の重畠を検証すべく熱電対を用いた実験を行ったところ、金属カーボンナノチューブへのスピントン注入実験により得られた起電力が、YIG基板上の熱勾配からゼーベック起電力により推定される熱起電力と同等であることがわかった。これにより、高ゼーベック係数材料に直流スピントンポンピング法を適用する際の問題点を明らかにした。</p> <p>第四章では、熱電対を用いたYIG上のスピントン波による熱輸送効果による効果の測定について詳述し、そのメカニズムをマイクロマグネットィック計算により議論した結果が述べられている。この熱輸送効果を引き起こすスピントン波(Damon-Eshbachモード、DEM)は磁性薄膜表裏で伝搬方向が対合するため、正味としての熱勾配を得るためにには磁性薄膜の表裏で励起されるスピントン波の強度に差をつけることが必要であるが、この章の実験では直流スピントンポンピング法にも用いられるESRキャビティにおいて、一様なマイクロ波分布下でDEMによる熱輸送効果を検証した。YIG薄膜上にSiO₂のスピントン流阻止層、CuとSbからなる薄膜型熱電対を設置し、直流スピントンポンピング法の設定において</p>				

京都大学	博士（工学）	氏名 重松 英
て熱起電力測定を行った。得られた熱起電力信号は、一様なマイクロ波励起においても YIG 薄膜表面側のスピノ波強度が裏面側よりも優勢であり熱輸送効果が発現していることを示唆した。この起源について YIG 薄膜裏面が GGG 基板と接していることによる磁化ダンピングの増大にあると考え、この状況をマクロマグネティック計算モデル上で再現し、一様な交流磁場による励起においても DEM の強度が表裏面で異なることが確認された。これら結果により、ESR キャビティによる一様なマイクロ波分布においても試料構造上の対称性の破れにより DEM による熱輸送効果が誘起されることがわかった。		
第五章では、先述の直流スピノポンピング法の問題点を踏まえ、交流スピノ流生成検出法を用いた半導体中のスピノ緩和の検討について述べられている。交流スピノ流生成検出法は米 NIST のグループにより 2018 年に提唱され、同グループでは Pt や Cu への交流スピノ流注入ならびにスピノ流電流変換の検出に成功している。この手法では非磁性体/磁性体二層構造をコプレーナ導波路に近接させ、磁性体の強磁性共鳴を誘起させた際のインダクタンス応答を解析することでスピノ軌道トルク伝導度と呼ばれるスピノ流電流変換効率を求めることができる。この章では Si のドープ元素とドーピング濃度を系統的に幅広く変化させた $Ni_{80}Fe_{20}/Cu/Si$ 構造を用いて先述の手法を適用した。測定により得られたスピノ軌道トルク伝導度はドープ元素とドーピング濃度に対して依存性を持ち、スピノ流電流変換のドーピングによる変調を強く示唆する結果を得、Si バルクあるいは Si/Cu 界面におけるスピノ流電流変換の起源として、逆スピノホール効果や逆 Rashba-Edelstein 効果の寄与を議論した。この結果により、Si におけるスピノ流電流変換物性を新たな視点で明らかにすることができ、さらに交流スピノ流生成検出法が半導体などの広範な固体物質に適用可能であることが示された。		
第六章では、スピノ流物性のうちスピノ流輸送物性に着目し、半導体 3C-SiC を、スピノ流チャネルの候補となり得る新規材料としてスピノ流輸送実験を行った。一般に原子番号の小さい元素は結晶場が小さくスピノ軌道相互作用が小さいと期待される。一方、結晶反転対称性を欠く系では Dresselhaus 型スピノ軌道相互作用が発現しスピノコヒーレンスが低減する。ここで 3C 晶系の SiC に着目すると、軽元素で構成されていながら閃亜鉛鉱型構造を持っているため、軽元素性と結晶反転対称性のいづれが強くスピノ緩和に働くか、大きな興味が持たれる。そこで、このような系のスピノ緩和物性の理解に向けて、直流スピノポンピング法を用いた横型スピノ流輸送素子による SiC 中のスピノ輸送実験を行った。n 型 3C-SiC チャネル上に強磁性金属と非磁性金属を平行に配置した素子において、注入されたスピノ流がチャネル輸送を経て非磁性体金属中でスピノホール起電力として観測された。実験は室温で行われ、輸送長は $1.2 \mu m$ であった。この成果は 3C-SiC がスピントロニクス素子のチャネル材料としての有望性を示すものである。		
第七章では、以上の研究結果をまとめた上で、将来における研究の進展について展望を述べている。		

氏名	重松 英
----	------

(論文審査の結果の要旨)

本論文では、固体中のスピニン流の輸送現象・スピニン流電流変換現象に焦点を置き、種々の固体物質中に交流・直流スピニン流を生成させる実験を行った結果をまとめている。その過程でスピニン流物性の評価法の確立に向けた学理的・技術的に優れた知見が得られた。主な成果を以下に示す。

- Pt/YIG 二層構造における直流スピニンポンピング法でのスピニン注入効率の温度依存性を常温から 80 K の領域で明らかにした。さらに詳細な実験から、YIG 中の希土類不純物による Slow Relaxation 機構が低温域で磁化ダンピングを増大させ、スピニン注入効率の低減に繋がっていることが示唆された。
- YIG 表面のスピニン波による熱輸送効果を、薄膜型熱電対構造を用いて一様マイクロ波分布下で観測した。マイクロマグネティック計算により、磁化ダンピングに関する対称性の破れによっても同効果が発現することを明らかにした。
- 直流スピニンポンピング法における問題点を回避するため、交流スピニン流生成検出法を半導体 Si に適用した。ドープ元素やドーピング濃度に依存したスピニン流電流変換効率の変調が見られ、そのメカニズムについて逆スピニンホール効果・逆 Rashba-Edelstein 効果に基づいて議論した。
- n 型 3C-SiC をチャネルとしたスピニン輸送デバイスを作製し、常温における $1.2 \mu\text{m}$ のスピニン輸送を示す信号が得られた。

本論文は、申請者の研究が世界的に当該研究分野において優れた内容と先進性を有しており、また申請者が本研究に関する十分な物理的知見を深い理解を有しており、学術上、实际上寄与するところが少なくない。よって、本論文は博士（工学）の学位論文として価値あるものと認める。また、令和元年 12 月 16 日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行って、申請者が博士後期課程学位取得基準を満たしていることを確認し、合格と認めた。

なお、本論文は京都大学学位規程第 14 条第 2 項に該当するものと判断した。このため、公表に際しては当該論文の全文に代えてその内容を要約したものとすることを認める。